

2SC920

NPN エピタキシャル形シリコントランジスタ／NPN Epitaxial Silicon Transistor

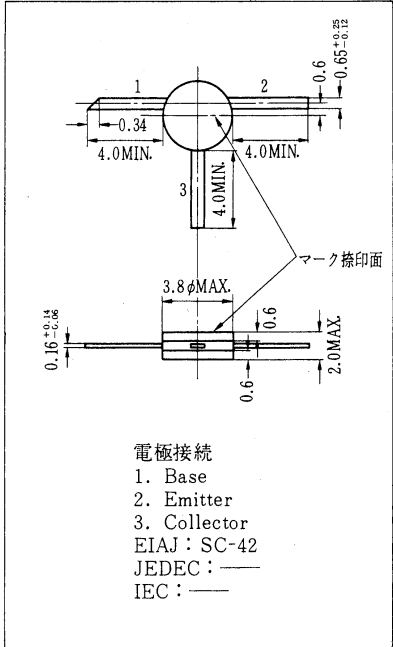
高周波増幅および周波数変換用／High Frequency Amplifier, Frequency Converter (単位：mm)

マイクロディスク／MICRODISK

- 特 徴
- 小形ラジオの高周波増幅，周波数変換，混合，発振，FM IF 増幅用として最適です。
 - 外形が小さいので機器の小形化が可能です。
 - マイクロディスク形なので取付時間の節約および自動組立が可能です。
 - 自動生産ラインの採用により特性が均一です。

絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

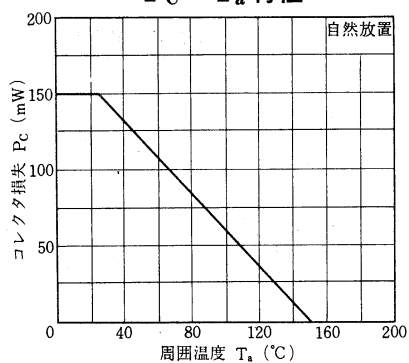
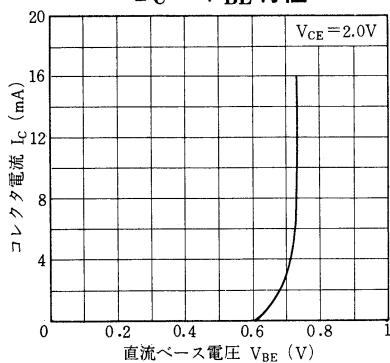
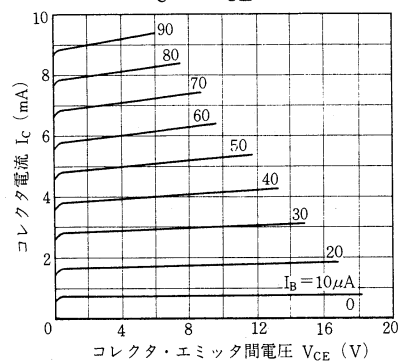
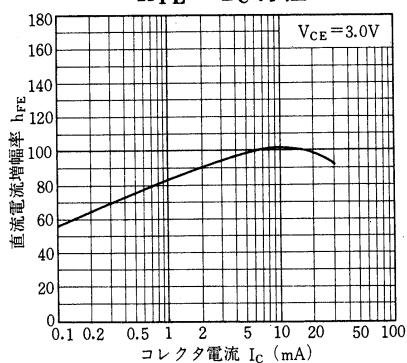
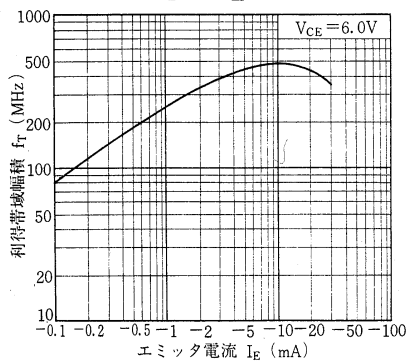
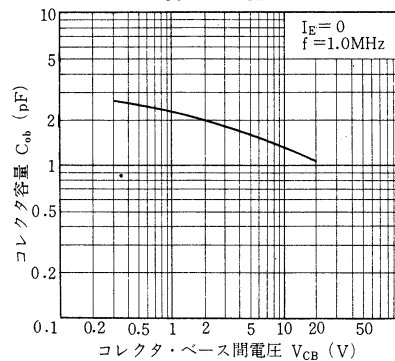
項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V _{CBO}	50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	25	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	5.0	V
コレクタ電流	I _C	30	mA
コレクタ損失	P _C	150	mW
ジャンクション温度	T _j	150	°C
保存温度	T _{stg}	−65〜+150	°C



電気的特性／Electrical Characteristics (Ta=25°C)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I _{CBO}	V _{CB} =15V, I _E =0			0.1	μA
エミッタシャ断電流	I _{EBO}	V _{EB} =3.0V, I _C =0			0.1	μA
直流電流増幅率	h _{FE}	V _{CE} =3.0V, I _C =0.5mA	30	75	215	
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =10mA, I _B =1.0mA			0.6	V
利得帯域幅積	f _T	V _{CE} =6.0V, I _E =−1.0mA	150	250		MHz
コレクタ容量	C _{ob}	V _{CB} =6.0V, I _E =0, f=1.0MHz		1.5	2.5	pF
C _c ・r _b 'b 積	C _c ・r _b 'b	V _{CE} =6.0V, I _E =−1.0mA, f=31.9MHz			50	ps
雑音指数	NF	V _{CE} =6.0V, I _E =−0.5mA, f=1.0MHz, R _G =500Ω		2.5	3.5	dB

h _{FE} 区分
30〜53 36〜80 58〜128 100〜215

特性曲線 ($T_a=25^\circ\text{C}$) P_C-T_a 特性 I_C-V_{BE} 特性 I_C-V_{CE} 特性 $h_{FE}-I_C$ 特性 f_T-I_E 特性 $C_{ob}-V_{CB}$ 特性

NF-f 特性

